

電源スイッチ用 2素子内蔵複合トランジスタ

VT6T12

●構造

PNP エピタキシャルプレーナ形
シリコントランジスタ

●特長

- 1) 超小型 2 素子入りパッケージ
- 2) カレントミラー回路に最適

●用途

カレントミラー回路用

●包装仕様

Type	包装名	テーピング
	記号	T2R
	基本発注単位 (個)	8000
VT6T12		○

●絶対最大定格 (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	-50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CE0}	-50	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EB0}	-5	V
コレクタ電流	I _c	-100	mA
	I _c *1	-200	mA
許容損失	P _D Total	150	mW
	P _D 素子*2	120	mW
ジャンクション温度	T _j	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55 ~ +150	°C

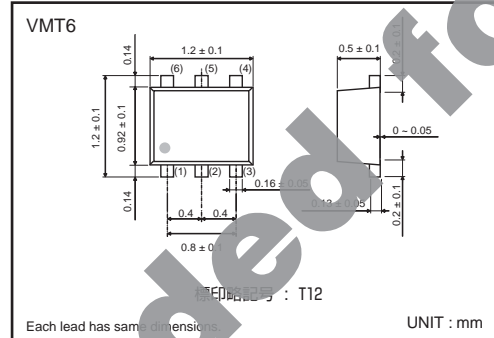
*1 Pw=1mS 単パルス

*2 各端子を推奨ランドに実装した場合

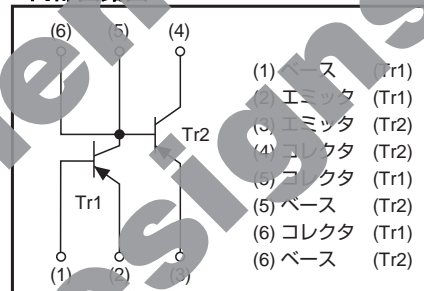
●電気的特性 (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV _{CEO}	-50	—	—	V	I _c = -1mA
コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CB0}	-50	—	—	V	I _c = -50μA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV _{EBO}	-5	—	—	V	I _E = -50μA
コレクタ遮断電流	I _{CB0}	—	—	-0.1	μA	V _{CB} = -50V
エミッタ遮断電流	I _{EBO}	—	—	-0.1	μA	V _{EB} = -5V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	—	-0.15	-0.4	V	I _c = -50mA, I _E = -5mA
直流電流増幅率	h _{FE}	120	—	560	—	V _{CE} = -6V, I _c = -1mA
直流電流増幅率比	h _{FE} (Tr1) / h _{FE} (Tr2)	0.9	—	1.1	—	V _{CE} = -6V, I _c = -1mA
利得帯域幅積	f _r	—	300	—	MHz	V _{CE} = -10V, I _E = 10mA, f = 100MHz
出力容量	C _{ob}	—	2	—	pF	V _{CB} = -10V, I _E = 0A, f = 1MHz

●外形寸法図 (Unit : mm)



●内部回路図



●電気的特性曲線

